



162162

客戶編號: TSMC2000-0856/91-01-22

本所編號: 0503-7148TWf/spin / Chen



G00002

發明名稱：防止光阻殘渣產生的方法

發明摘要：

本發明揭示一種防止光阻殘渣產生的方法。首先，提供一基底，在基底上形成有一介電層。接著，在介電層上形成一非胺類（non-amine）抗反射層。最後，在非胺類抗反射層上形成一光阻圖案層，期間非胺類抗反射層不與光阻圖案層交互作用而不形成光阻殘渣（scum）以防止光阻殘渣造成後續蝕刻輪廓（profile）不佳及關鍵圖形尺寸（critical dimension, CD）改變等問題。其中，非胺類抗反射層係氧化矽（ SiO_x ）及含碳氫之氧化矽（ $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}$ ）之一種。

FIG 2e